
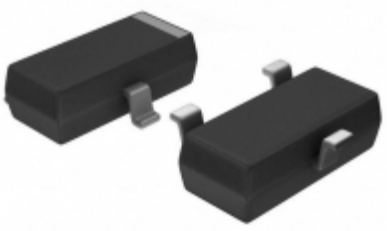





	<p><b>SI2399DS-T1-GE3</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI2399DS-T1-GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 20V 6A SOT-23</p> <p><b>Datenblätter:</b>  SI2399DS-T1-GE3.pdf</p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 101345 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI2399DS-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 6A SOT-23
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	101345 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 6A (Tc) 1.25W (Ta), 2.5W (Tc) Surface
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23-3 (TO-236)
Verlustleistung (max)	1.25W (Ta), 2.5W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	34 mOhm @ 5.1A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	835pF @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 10V
Vgs (Max)	±12V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI2399DS-T1-GE3-ND

SI2399DS-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI2399DS-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI2399DS-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI2399DS-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI2399</b> SIPU SI2399 SIPU</p>	 <p><b>SI2400-BS</b> Energy Micro (Silicon Labs) IC ISOMODEM SYSTEM-SIDE 16SOIC</p>	 <p><b>SI2399CDS-T1-GE3</b> V SI2399CDS-T1-GE3 V</p>	 <p><b>SI2399DS-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 6A SOT-23</p>
 <p><b>SI2392DS-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 100V 3.1A SOT-23</p>	 <p><b>SI2400-FS</b> Energy Micro (Silicon Labs) IC ISOMODEM SYST-SIDE DAA 16SOIC</p>	 <p><b>SI2400-KS</b> Energy Micro (Silicon Labs) IC ISOMODEM SYSTEM-SIDE 16SOIC</p>	 <p><b>SI2392DS-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 3.1A SOT-23</p>

heiße Teile

Mehr

SI2366DS-T1-GE3	SI2367DS-T1-E3	SI2367DS-T1-GE3	SI2367DS-T1-GE3	SI2369DS-T1-GE3
SI2369DS-T1-GE3	SI2371EDS-T1-GE3	SI2371EDS-T1-GE3	SI2372DS-T1-E3	SI2372DS-T1-GE3
SI2372DS-T1-GE3	SI2374DS-T1-GE3	SI2374DS-T1-GE3	SI2377DS-T1-GE3	SI2377EDS
SI2377EDS-T1-E3	SI2377EDS-T1-GE3	SI2377EDS-T1-GE3	SI2392ADS-T1-E3	SI2392ADS-T1-GE3
SI2392ADS-T1-GE3	SI2392DS-T1-GE3	SI2392DS-T1-GE3	SI2399CDS-T1-GE3	SI2399DS-T1-GE3
SI2400-BS	SI2400-FS	SI2400-FSR	SI2400-KS	SI2400-KSR
SI2401-FS	SI2401-FSR	SI2401-FSR.	SI2401-KS	SI2403-FTR
SI2404-C-FSR	SI2404-C-FTR	SI2404-C-ZSR	SI2404-CFTRP	SI2404-FS
SI2404-FT	SI2413AP	SI2414-F-FTR	SI2414-FT	SI2414-FTR
SI2414-KT	SI2415-C-FT	SI2415-FS	SI2415-FT	SI2417-B-FTR

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited